版权所有 © 《激光技术》编辑部 http://www.jgjs.net.cn

第42卷 第4期	激 光 技 术	Vol. 42, No. 4
2018年7月	LASER TECHNOLOGY	July,2018

文章编号: 1001-3806(2018)04-0457-05

垂直腔面发射激光器的温度特性研究

戚向涛^{1,2},顾亚平^{1,2}*,张 曼^{1,2},方斯喆^{1,2}

(1. 中国科学院大学,北京 100049;2. 中国科学院 声学研究所,北京 100190)

摘要:为了研究垂直腔面发射激光器(VCSEL)输出的光功率与器件温度的关系,确定用户可正常使用网络的温度范围,采用输出光功率与工作电流关系(*P-I*)模型进行了理论分析及实验验证,并通过简化模型参量及引入电压与电流关系(*U-I*)特性曲线来优化模型。采用了 Levenberg-Marquardt(LM)算法来实现模型参量的求解,对比 20℃下的测量数据与拟合数据的相似度,预测得到不同温度下的 *P-I* 特性曲线数据。结果表明,在固定温度下,输出光功率随着驱动电流的增加先增后减;在固定的驱动电流下,输出光功率随着温度增加而减小;要保证用户正常上网,电机房里 VCSEL 激光器工作的环境温度最多不能高于 31℃。

关键词:激光器;温度特性;输出光功率与工作电流关系(*P-I*);垂直腔面发射激光器;Levenberg-Marquardt算法 **中图分类号:** TN248.4 **文献标志码:** A **doi**:10.7510/jgjs. issn. 1001-3806. 2018. 04. 005

Study on temperature characteristics of vertical cavity surface emitting lasers

QI Xiangtao^{1,2}, GU Yaping^{1,2}, ZHANG Man^{1,2}, FANG Sizhe^{1,2}

(1. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 2. Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: In order to study relationship between output power and device temperature of a vertical cavity surface emitting laser (VCSEL) and determine the temperature range at which the user can use the network normally, the relationshipmodel between output power and working current (P-I) was used to do theoretical analysis and experimental verification. Then the model was optimized by simplifying the parameters and introducing voltage-current (U-I) relationship curve. The model parameters were obtained by means of Levenberg-Marquardt (LM) algorithm. The P-I characteristic curve data at different temperature, optical output power increases first and then decreases with the increase of driving current. At the fixed driving current, optical output power decreases the increase femperature. To ensure the normal Internet using, room temperature of VCSEL laserscan notbe higher than 31 °C.

Key words: lasers; temperature characteristics; relationship between output power and working current (*P-I*); vertical cavity surface emitting laser; Levenberg-Marquardt algorithm

引 言

激光信号具有远高于电信号传输速率的特点,更适合于未来高速率的传输网络^[13]。激光器作为光纤通信系统的核心器件是系统仿真中考虑的一个重要因素。垂直腔面发射激光器(vertical cavity surface emitting laser, VCSEL)具有使用简单、功耗较低等特点,目前广泛应用于光纤通信和光信号处理领域^[45]。 VCSEL 激光器输出的光功率与器件的温度相关,当器

作者简介:戚向涛(1990-),女,博士研究生,研究方向为 图像处理。

* 通讯联系人。E-mail:gyp@mail.ioa.ac.cn 收稿日期:2017-10-23;收到修改稿日期:2017-12-05 件温度改变后,激光器输出的光功率也会相应发生变化^[6-8]。准确地分析激光器的温度特性可以保证激光器在合理的外界环境温度范围内使用^[9]。

国内外很多学者研究仿真温度对 VCSEL 性能的 影响,并建立了大量的模型。NAKWASKI 建立了 2 维 热效应模型^[10-11]。YU 等人建立用于单模模拟的 VC-SEL 的速率方程模型^[12]。MOROZOV 等人考虑多模 行为的速率方程模型^[13]。SU 等人建立的静态热特性 模拟的温度相关模型^[14]。

本文中通过建立光功率与工作电流关系(P-I)模型,并简化模型参量及引入电压电流关系(U-I)特性曲线来优化分析模型。使用 Levenberg-Marquardt (LM)算法来实现模型的求解。对比分析 20℃下的测

量数据与拟合数据的相似度,进一步来预测不同温度 下的 P-I 特性曲线,并分析用户可正常使用网络的温 度范围。

1 VCSEL 的 P-I 模型及优化

1.1 P-I 模型建立

VCSEL 的输出光功率 P_0 和外部驱动电流 I 满足可以用下式来表示,这里 P_0 与 I 的建模关系称为 P-I建模^[15]:

$$P_0 = \eta(T) \left[I - I_{\rm th}(N,T) \right] \tag{1}$$

式中, P_0 表示激光器输出的光功率;I表示注入到激光器的外部驱动电流,包含外部加载的偏置电流 I_b 和信号电流,在没有信号输入时驱动电流为偏置电流 I_b ; $\eta(T) \ge P-I$ 曲线的斜率,其大小与温度T相关,从能量转换角度看,斜率相当于转换效率:斜率越高,相同电流I对应的输出光功率越高,那么相同电能可转换的光能越多; $I_{tb}(N,T)$ 表示阈值电流,其大小主要和载流子数N及温度T相关。

为简化(1)式的表达,可以假设转换效率 $\eta(T)$ 受 温度影响较小^[16],即 $\eta(T)$ 近似于常数 η 。同时假设 忽略空间烧孔效应的影响。阈值电流可以表示为只与 温度相关的函数^[14],如下式所示:

 $I_{th}(N,T) = I_{th,0} + I_{off}(T)$ (2) 式中, $I_{th,0}$ 为常数, $I_{off}(T)$ 是与温度相关的经验热偏置 电流,该电流随激光器的变化而变化。 $I_{off}(T)$ 可以由 温度的多项式表示:

$$I_{\rm off}(T) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n \tag{3}$$

式中,a_n是多项式的参量,n表示阶数。

此时(1)式可以表示为:

$$P_0 = \eta (I - I_{\text{th},0} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n T^n)$$
 (4)

式中, $\eta(T)$ 表示转换效率, 是 *P-I* 曲线的斜率。本文 中假设 $\eta(T)$ 受温度影响较小, $\eta(T)$ 近似于常数 η , 模 型求解中, η 同样为待求参量。温度 *T* 受环境温度 *T*₀ 以及自身的温度影响,自身的温度与器件产生的瞬时 功率 *P_i* 相关,瞬时功率 *P_i* = *UI*, 即受 *U-I*(电压-电流) 特性影响:

$$T = T_0 + (UI - P_0)R_{\rm th} - \tau_{\rm th} \frac{{\rm d}T}{{\rm d}t}$$
(5)

式中, R_{th} 表示 VCSEL 热阻抗; τ_{th} 表示热时间常数; T_0 代表环境温度;此处 I 为偏置电流 I_b , U 表示输入电 压。 假设温度不发生变化时,(5)式后面微分项可忽略不计。结合(2)式~(5)式可以得到 *P*₀ 和 *I* 的隐式关系:

$$P_{0} = \eta \{ I - I_{\text{th},0} - \sum_{n=0}^{\infty} a_{n} [T_{0} + R_{\text{th}} (UI - P_{0})]^{n} \}$$
(6)

1.2 P-I 模型参量的优化

模型的参量多少决定该模型整体的运行速度。参 量太多会使得模型计算量增大,并且容易产生过拟。 所以适当地优化参量个数在优化网络的同时会提高模 型的计算精度。

将(4)式中的高次多项式展开可得:

$$P_0 = \eta (I - I_{\text{th},0} - a_0 - a_1 T - a_2 T^2 - a_3 T^3 - a_4 T^4 - \cdots)$$
(7)

根据(7)式可以看出,参量 *I*_{th,0}(*I*_{th,0}为常数,模型 求解中 *I*_{th,0}为待求参量)和参量 *a*₀ 皆为1 阶常量,这 里可以将这两个参量合并为一个参量,即可以将(3) 式优化为:

$$I_{\rm off}(T) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n T^n, (n = 1, 2, 3, \cdots)$$
(8)

▶ 故而可以在模型的整体计算上减少一个参量。随着 n 的增大,的值越来越小,并趋于 0。这里假设 n > 4 时,趋近为 0,所以取 n = 1,2,3,4。

此时,P₀和I的隐式关系为:

$$P_{0} = \eta (I - I_{\text{th},0} - a_{1}T - a_{2}T^{2} - a_{3}T^{3} - a_{4}T^{4})$$
(9)

式中, $T = T_0 + (UI - P_0) R_{\text{th}\circ}$

1.3 VCSEL 的 U-I 特性曲线

温度 T G P界环境温度 T_0 和自身的温度影响,自身的温度与器件产生的瞬时功率 P_i 相关,瞬时功率 $P_i = UI$ 相关,即受电压-电流(U-I)特性影响:

$$T = T_0 + (UI - P_0)R_{\rm th}$$
(10)

电压的变化关系和 VCSEL 的特性相关。为了简 化模型,可以认为电压主要受温度和电流的影响,即:

$$U = f(I, T_0) \tag{11}$$

在实际应用中,电压会随着温度和电流的变化而 变化,所以可以用多项式来拟合电压 *U* 的输出^[6],如 下式所示:

$$U = \left(\sum_{i=0}^{n} b_{i} T_{0}^{i}\right) \times \left(\sum_{j=0}^{m} c_{j} I^{j}\right)$$
(12)

式中,*b_i*和*c_j为多*项式的拟合参量;*n*,*m*为多项式的 拟合的阶数,0≤*i*≤*n*,0≤*j*≤*m*。利用(12)式,根据在 20℃的环境温度下得到的实验数据 *U*及 *I*,拟合其 *U*-*I* 第42卷 第4期

特性曲线。在20℃下,当*n*=2,*m*=4时,*U*-*I*特性曲线 与实测数据的对比图如图1所示。



Fig. 1 a-U-I curve of measurement data and fit data at 20°C b-U-I curve of different temperature

图 1 中的横坐标代表驱动电流,纵坐标代表电压。 图 1a 中的实线是温度为20℃时的实测 U-I 数据,虚线 是经过(12)式且 n = 2, m = 4 时拟合后的曲线。从图 1a 可以看出,拟合的数据可以较好地反映实际数据的 分布。图 1b 为根据拟合参量求得的在 10℃,20℃, 30℃,…,90℃温度下的 U-I 特性曲线。通过图 1b 可 以看出:(1)在固定温度下随着驱动电流的增加,电压 也会随之增加;(2)在固定的驱动电流下,随着温度的 增加,电压也会随之增加。

此时,模型整体修正为式:

$$P_0 = \eta (I - I_{\text{th},0} - a_1 T - a_2 T^2 - a_3 T^3 - a_4 T^4 - \cdots)$$
(13)

式中,

$$T = T_0 + \left[I(\sum_{i=0}^n b_i T_0^{i}) (\sum_{j=0}^m c_j I^j) - P_0 \right] R_{\text{th}}$$
(14)

2 基于 LM 算法的模型求解

LM 算法结合了 Gaussian-Newton 法和梯度下降法,利用标准值优化初值,是一种快速算法。具有稳定性强和快速收敛等优点,是快速有效求解目标函数的常用方法^[17]。所以选择 LM 算法来求解(13)式。

在 LM 算法中,存在如下关系式^[18]:

$$\boldsymbol{u}_{k+1} = \boldsymbol{u}_k + \Delta \boldsymbol{u} \tag{15}$$

式中, u_k 为第k 次迭代时的输入向量, u_{k+1} 为第k+1 次迭代时的输入向量, Δu 为两次迭代时向量的变化量。此处 $u = [\eta, I_{th,0}, R_{th}, a_1, a_2, a_3, a_4]$ 是7 维向量, 是所需要求解的参量。

对于牛顿法有:

$$\Delta \boldsymbol{u} = - \left[\nabla^2 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{u}) \right]^{-1} \nabla \boldsymbol{E}(\boldsymbol{u})$$
(16)

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{e}_{i}^{2}(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} (P_{0} - P)^{2} (17)$$

式中, E(u) 是误差指数函数, $\nabla E(u)$ 为梯度, $\nabla^2 E(u)$ 为Hessian 矩阵, e(u) 为期望功率和实际功率 误差误差向量, P_0 为期望输出功率值, P 为实际输出 功率值。在此处, P 是已知的, h(14) 式得到关于未 知数 η , $I_{h,0}$, R_h , a_1 , a_2 , a_3 , a_4 的隐函数关系式。

$$\nabla^2 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{u}) = [\boldsymbol{A}(\boldsymbol{u})]^{\mathrm{T}} \boldsymbol{e}(\boldsymbol{u}) + \boldsymbol{S}(\boldsymbol{u}) \qquad (18)$$

$$\mathbf{S}(\boldsymbol{u}) = \sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{e}_{i}(\boldsymbol{u}) \nabla^{2} \boldsymbol{e}_{i}(\boldsymbol{u})$$
(19)

式中,A(u)为 Jacobian 矩阵。当目标接近极值时, S(u)很小,可忽略不计,此时:

$$\nabla^2 \boldsymbol{E}(\boldsymbol{u}) \approx [\boldsymbol{A}(\boldsymbol{u})]^{\mathrm{T}} \boldsymbol{e}(\boldsymbol{u})$$
 (20)

对 Gaussian-Newton 法:

 ∇

$${}^{2}E(\boldsymbol{u}) \approx [\boldsymbol{A}(\boldsymbol{u})]^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{u})$$
 (21)

迭代过程中,对E(u)的 Hessian 矩阵无法求逆时,需对E(u)的 Hessian 矩阵进行变形:

 $\nabla^2 E(u) \approx [A(u)]^T A(u) + \mu I(u)$ (22) 式中, I 为单位矩阵; μ 为阻尼系数, 且 $\mu > 0$ 为常数。 故有:

$$\nabla \boldsymbol{u} = - (\boldsymbol{A}_k^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}_k + \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{I})^{-1} \boldsymbol{A}_k^{\mathrm{T}} \boldsymbol{e}_k \qquad (23)$$

$$\boldsymbol{u}_{k+1} = \boldsymbol{u}_k - (\boldsymbol{A}_k^{\mathrm{T}} \boldsymbol{A}_k + \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{I})^{-1} \boldsymbol{A}_k^{\mathrm{T}} \boldsymbol{e}_k \qquad (24)$$

上面(15)式~(24)式即为 LM 算法的表达式, e_k 表示 $e(u_k)$ 。每次迭代时重新计算误差函数 $E(u_{k+1})$, 若其小于 $E(u_k)$,则保留此次迭代结果,减小阻尼系数 μ 来提高计算精度,并继续进行迭代,令 $\mu = \mu/\beta(\beta >$ 1, β 为大于 1 的常数);反之则增大阻尼系数 μ 后重新 计算,令 $\mu = \mu \cdot \beta$,直到满足 $E(u_{k+1}) < E(u_k)$ 时,停止 增大 μ 。

3 实验结果及分析

在 20℃的环境温度下得到的输出光功率 P₀ 和外 部驱动电流 I 的实验数据,根据改进的 P-I 模型,使用 LM 算法来求解模型,拟合 P-I 模型曲线。并给出不同 温度情况下(10℃,20℃,30℃,…,90℃)P-I 曲线的预 测结果。

模型的初始值和最终模型求解出的参量值如表1 所示。

Table 1 The initial value and the solved value of the improved P-I model

parameter	model solution value	initial value	unit
η	0.4803	0.5	_
$I_{\mathrm{th},0}$	-0.0094	0.3×10^{-3}	А
$R_{ m th}$	2.873×10^{3}	2.873×10^{3}	K/W
a_1	-1.7363×10^{-4}	-2.545×10^{-5}	A/K
a_2	1.6608 $\times 10^{-6}$	2.908×10^{-7}	A/K ²
a_3	-4.5594×10^{-9}	-2.531×10^{-10}	A/K ³
a_4	4.4282×10^{-12}	1.022×10^{-12}	A/K ⁴

3.1 20℃时 P-I 曲线

图 2 是温度为 20℃ 时的实测数据与拟合数据的 P-I曲线结果对比图。图2中横坐标代表驱动电流,纵 坐标代表光功率,其中实线为拟合数据、虚线为实测数 据。从图2中可以看出,模型几乎可以拟合出实测数 据的趋势,并且拟合曲线相对测试曲线更加平滑。





3.2 不同温度下 P-I 曲线

将模型求解的参量值 η , $I_{\text{th},0}$, R_{th} , a_1 , a_2 , a_3 , a_4 代 入(14)式,并求解温度在10℃,20℃,30℃,…,90℃下 的 P-I 曲线, 如图 3 所示。图 3a 表示完全按照模型拟 合出的各 P-I 曲线, 不考虑物理情况下光功率不能小 于0。图3b显示为光功率大于0时的P-I曲线。

由图 3a 可以看出,光功率随着温度和驱动电流变 化的整体走势。同样在固定温度下,输出光功率随着 驱动电流的增加先增后减;在固定的驱动电流下,输出 光功率随着温度增加而减小。因为光功率不可能小于 0,所以光功率小于0时都强制置为0。从图 3b 可以 看出,当温度不大于60℃时才会有光功率输出。所以 想要有光功率输出,则温度不能高于60℃。

目前假定电信机房里 VCSEL 激光器在直流输入 且输出的平均光功率低于 2mW 时,用户的光猫无法 检测到信号。分析图 3b,当温度为 30℃时,光功率在 2mW 左右浮动,所以细分位于 30℃ 附近(24℃~32℃)



a—10 $^{\circ}$ C ~ 90 $^{\circ}$ C (power unlimited) b—10 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C (power > 0mW) 的 P-I 曲线图, 近一步精确地推测激光器正常工作的 温度。

图 4 显示了 24℃~32℃温度时的 P-I 曲线。从图 上可以看出,只有在光功率大于 2mW 时才能保证激 光器被检测到,保证用户正常使用网络;当温度大于 31℃时,任何驱动电流下都不会有光功率大于 2mW。 所以要保证用户正常上网,电机房里 VCSEL 激光器工 作的环境温度最多不能高于31℃。



论 4 结

主要研究了 VCSEL 的 P-I 模型的温度特性。首 先通过对 P-I 模型进行建模,并通过简化参量及引入 U-I特性曲线来优化分析模型。模型使用 LM 算法计 算模型参量。根据在20℃下的实测数据,计算出模型 的拟合参量,最终在 20℃下采用 P-I 模型拟合 P-I 曲 线效果非常好,与实测的 P-I 曲线非常吻合。同时根

版权所有 © 《激光技术》编辑部 http://www.jgjs.net.cn

第42卷 第4期

据建立的模型对不同温度下的 P-I 曲线进行了分析, 指出了用户可正常使用网络的温度范围。

参考文献

- [1] WANG H X, CHEN J D, CHANG T Y, et al. Reaserch of modudation characteristics of distributed feedback laser[J]. Laser Technology, 2017, 41(6): 836-840 (in Chinese).
- [2] JIAN X H, HAN Zh L, DONG Zh L, et al. Status and selection of photoacoustic imaging exciting laser sources [J]. Laser Technology, 2017, 41(5):712-716 (in Chinese).
- [3] DUAN H. The response characteristics of semiconductor lasers based on rate equations [D]. Qinhuangdao: Yanshan University, 2010:1-83(in Chinese).
- [4] LI F L, CHEN J J. Polarization switch and bistability in long-wavelength vertical-cavity surface-emitting lasers [J]. Laser Technology, 2015,39(4):515-519 (in Chinese).
- [5] ZHANF P, YU W M, SONG Y R. Technology of SESAM modelocked OP-VECSELs[J]. Laser Technology, 2007, 31(3):291-294 (in Chinese).
- YU Ch Y. Numerical simulation and characteristic investigation of vertical-cavity surface-emitting lasers based on rate-equations [D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2006:1-79 (in Chinese).
- [7] MENA P V, MORIKUNI J J, HARTON A V. A simple rate-equationbased thermal vcsel model [J]. Journal of Lightwave Technology, 1999, 17(5):865-872.
- [8] SALE T E, ROBERTS J S, DAVIDJ P R. Temperature effects in VC-SEL's[J]. Proceedings of the SPIE, 1997, 3003:100-110.
- [9] LIANG F, GAO J J, TIAN X N. An improved thermal model for a VCSEL[J]. Chinese Journal of Semiconductors, 2007, 28(7):1125-1129 (in Chinese).

AND FITTE

- [10] NAKWASKI W. Thermal aspects of efficient operation of vertical cavity surface-emitting lasers [J]. Optical & Quantum Electronics, 1996, 28(4): 335-352.
- [11] QSINSKI M, NAKWASKI W. Thermal effects in vertical-cavity surface-emitting lasers [J]. International Journal of High Speed Electronics & Systems, 1994, 5(4): 667-730.
- [12] YU S F, WONG W N, SHUM P, et al. Theoretical analysis of modulation response and second-order harmonic distortion in vertical cavity surface-emitting lasers[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1996, 32(12): 2139-2147.
- [13] MOROZOV J V N, NEFF J A, ZHOU H. Analysis of vertical-cavity surface-emitting laser multimode behavior [J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1997, 33(6): 980-988.
- [14] SU Y, CHANG Y, CHEN X. Circuit model for studying temperature effects on vertical-cavity surface-emitting laser[C]// Lasers and Electro-Optics Society Meeting, 1996. New York, USA: IEEE, 2002,1:215-216.
- [15] COLDREN L A, SCOTT J W, GEELS R S, et al. Modeling temperature effects and spatial hole burning to optimizevertical-cavity surface[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1993, 29 (5): 1295-1308.
- [16] MICHALZIK R, EBELING K J. Modeling and design of proton-implanted ultralow-threshold vertical-cavity laser diodes [J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1993, 29(6):1963-1974.
- [17] MIRZAEE H. Long-term prediction of chaotic time series with multistep prediction horizons by a neural network with Levenberg-Marquardt learning algorithm [J]. Chaos, Solitons & Fractals, 2009, 41 (4): 1975-1979.
- [18] WANG B X. Research on LM optimization algorithm and neural network predictive control in nonlinear system [D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2016;1-85 (in Chinese).